

ダイオード RECTIFIER DIODES

SHINDENGEN ELECTRIC MFG

32E D

8219387 000014 3 SHEJ

面実装ダイオード Surface-mount Diodes

T-03-15

- HICおよび両面基板に実装できるように設計されています。
- 梱包形態はマガジンおよびテープリールです。
- チップマウンターにて実装できます。

単体ダイオード Single Diodes

品名 Type No.	絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings						電気的・熱的特性 Electrical Characteristics						備考 Remarks	外形 No. Outline No.
	V _{RM} [V]	I _O [A]	条件 T _a [°C]	I _{FSM} [A]	T _{stg} [°C]	T _j [°C]	V _F (max) [V]	条件 I _F [A]	I _R (max) V _R =V _{RM} [μA]	t _{rr} (max) [nS]	θ _{JL} (max) [°C/W]	θ _{JA} (max) [°C/W]		
D1FK20 40	200 400	0.8	25	25	-55~+150	+150	1.2	0.8	10	300	23	108	FRD	Fig. 61
D1F10 20 40 60	100 200 400 600													
D1FL20 D1FS4	200 40	1.1 1.1	25 25	30 30	-55~+150 -55~+125	+150 +125	0.98 0.55	1.1 1.1	10 1000	50 —	23 23	108 108	LLD SBD	Fig. 61 Fig. 61
D2FK20 40	200 400	1.3	25	50	-55~+150	+150	1.2	1.3	10	300	24	90	FRD	Fig. 62
D2F10 20 40 60	100 200 400 600													
D2FL20 D2FS4	200 40	1.6 1.6	25 25	50 60	-55~+150 -55~+125	+150 +125	0.98 0.55	1.6 1.6	10 1000	50 —	24 24	90 90	LLD SBD	Fig. 62 Fig. 62

ツインダイオード(アレイタイプ) Twin Diodes(Array Type)

品名 Type No.	絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings						電気的・熱的特性 Electrical Characteristics						備考 Remarks	外形 No. Outline No.
	V _{RM} [V]	I _O [A]	条件 T _a [°C]	I _{FSM} [A]	T _{stg} [°C]	T _j [°C]	V _F (max) [V]	条件 I _F [A]	I _R (max) V _R =V _{RM} [μA]	t _{rr} (max) [nS]	θ _{JL} (max) [°C/W]	θ _{JA} (max) [°C/W]		
S1ZAK20 40	200 400	0.7	25	25	-40~+150	+150	1.2	0.7	10	300	—	120	FRD	Fig. 63
S1ZA10 20 40 60	100 200 400 600													
S1ZAL20 S1ZAS4	200 40	1.2 1.1	25 25	30 30	-40~+150 -40~+125	+150 +125	0.98 0.55	1.2 1.1	10 1000	50 —	25 25	120 120	LLD SBD	Fig. 63 Fig. 63

FRD : Fast Recovery Diode

SBD : Schottky Barrier Diode

LLD : Low Loss Diode

外形図 Outline Dimensions

[Unit : mm]

Fig. 60

Fig. 61

Fig. 62

